

**产品特性：**

工作频率：8.5~9.6GHz

饱和输出功率： $P_{\text{sat}} \geq 50\text{dBm}$

功率增益： $\text{Gain} \geq 8.5\text{dB}$

附加效率： $\text{PAE} \geq 36\%$

端口匹配： $Z_{\text{in}}/Z_{\text{out}} = 50\Omega$

**产品说明：**

HXN40095是一款氮化镓内匹配功率管，采用先进的平面内匹配合成技术和成熟的薄膜混合集成工艺，产品的典型工作频带为8.5~9.6GHz，具有高功率、高效率及温度等环境适应性等特点，能够广泛应用于各种射频/微波系统中。

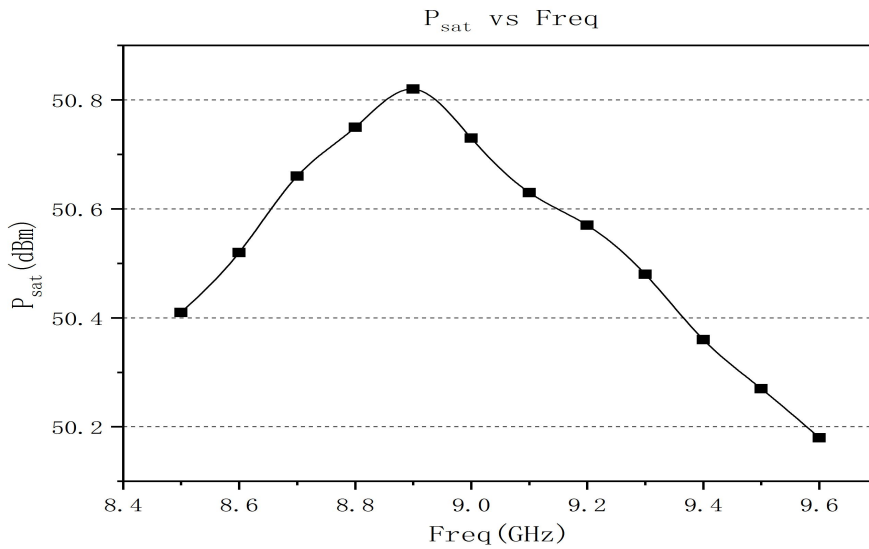
**最大额定值 (  $T_c = 25^\circ\text{C}$  ，不建议在此条件下使用 )：**

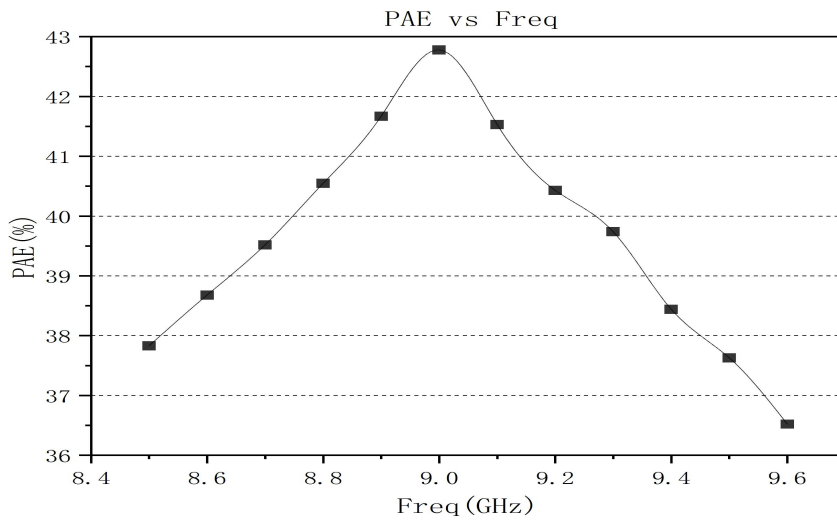
	符号	值	单位
漏源电压	$V_{\text{DS}}$	40	V
栅源电压	$V_{\text{GS}}$	-5	V
存储温度	$T_{\text{stg}}$	-65 to +175	$^\circ\text{C}$
沟道温度	$T_{\text{ch}}$	175	$^\circ\text{C}$

**微波电性能：**

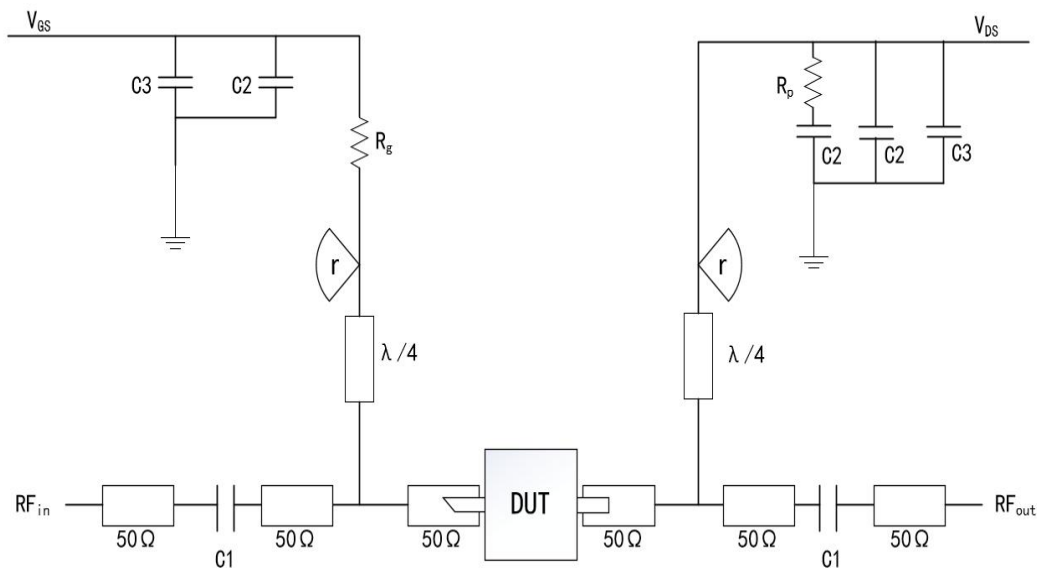
	符号	测试条件	值			单位
			Min	Typ	Max	
漏极电流	$I_{dsr}$	$V_{DS}=28V$	-	8.5	-	A
饱和输出功率	$P_{sat}$	脉冲工作	50	-	-	dBm
功率增益	$G_p$	$T=1ms, Duty=10%$	8.5	-	-	dB
附加效率	PAE	$P_{in} : 41.5dBm$	36	-	-	%
增益平坦度	$\Delta G$	Freq : 8.5~9.6GHz	-0.8	-	+0.8	dB

**典型曲线：**





**推荐应用电路：**



DUT : 待测器件

C1:1pF

$R_p$ :51 $\Omega$

C2:1000pF

$R_g$ :15 $\Omega$

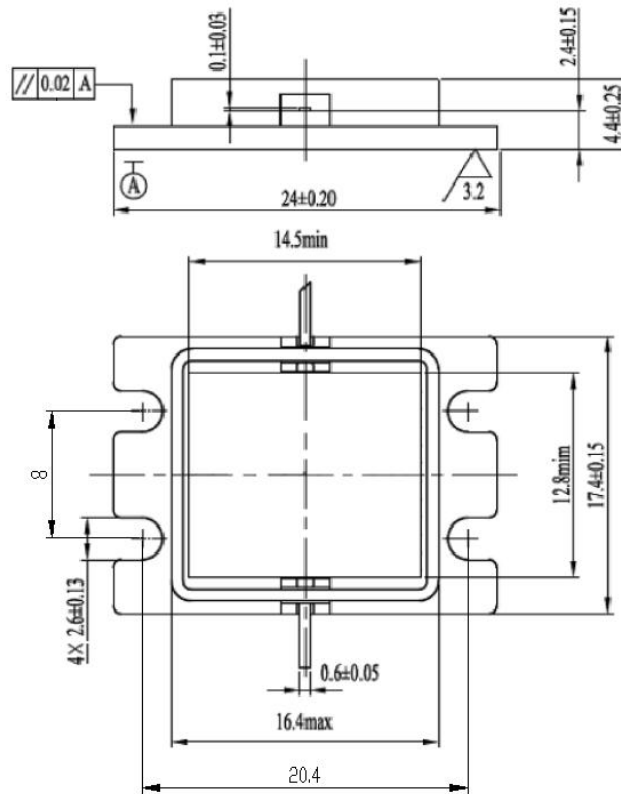
C3:100uF

$r$  半径 $\approx$ 3.5mm ( Rogers5880 , 20mil )

**防静电等级：**

ESD	Class III	2000V
-----	-----------	-------

**外观尺寸：**



**使用注意事项：**

- 运输存储过程中注意干燥。
- 芯片使用、装配过程中注意防静电，戴接地防静电手镯。
- 加电时先加栅电再加漏电。